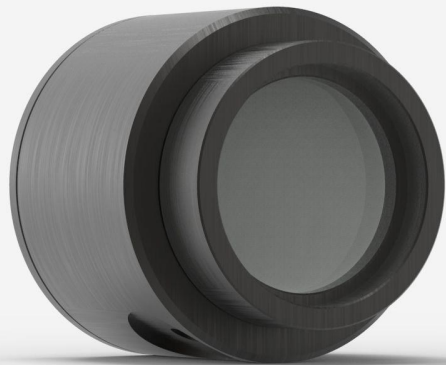


PH100-SI-HA-OD1-D0

最大300 mWまでのレーザー出力測定用フォトダイオードディテクタ。



プロダクトファミリーの主な特長

大型アパーチャ

シリコンセンサーには10 mm $\varnothing$

3つのバージョン

- シリコン350 - 1080 nm、最大750mW
- シリコンUV 210 - 1080 nm、最大38mW
- ゲルマニウム800 - 1650 nm、最大500mW

アッテネーターの選択

高精度

新 PH100-SI-HAは、キャリブレーションの安定性に優れています。

精密較正

1nmステップでの波長の選択

スマートインターフェース

すべての校正データを収容

互換性のあるスタンド

[STAND-D-233](#)

仕様

測定性能	
最大平均出力 ¹	300 mW
ノイズ等価出力 ²	200 pW
スペクトル領域	400 - 1080 nm
標準上昇時間	0.2 s
出力校正不確実性 ³	±5.0 % (400 - 419 nm) ±4.0 % (420 - 899 nm) ±5.0 % (900 - 1009 nm) ±7.5 % (1010 - 1080 nm)
ピーク感度	980 nm
最小繰り返し率 ⁴	1000 Hz
1. 1064 nm、減衰器搭載。その他の波長における最大出力については曲線を参照してください。 2. 980 nmで。公称値。実際値は周囲の電磁妨害および波長に応じて異なります。 3. 減衰器搭載。減衰器なしの校正不確実性についてはユーザーマニュアルを参照してください。 4. 詳細についてはユーザーマニュアルを参照してください。	
損傷閾値	
最大平均出力密度	100 W/cm ²
物理的特徴	
開口直径	10 mm
吸収材	Si
寸法	38.1 $\varnothing$ x 36D mm
重量	0.14 kg
センサ正面までの距離	13.7 mm
注文情報	
PH100-SI-HA-OD1-D0	202683
PH100-SI-HA-OD1-INT-D0	202784
PH100-SI-HA-OD1-IDR-D0	203221

本製品にご興味をお持ちですか？

見積をリクエスト

gentec-eo.com/ja/contact-usで最寄りのセールス担当者をお探してください